

## Механизированная (ручная) установка монтажа полупроводниковых элементов (кристалла) на паяльную пасту/клей.

Установка предназначена для механизированного монтажа полупроводниковых кристаллов в корпус или на плату. Установка подходит для мелкосерийного производства изделия электронной техники. Установка позволяет производить монтаж полупроводниковых кристаллов с применением следующих технологий – монтажа кристаллов с помощью дозирования клея или методом штемпелевания клея.

Механизированная установка УМС-1ПК настольного исполнения.

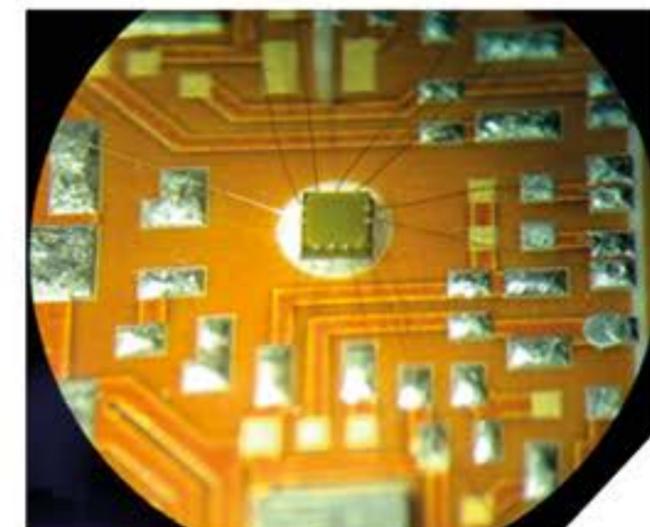
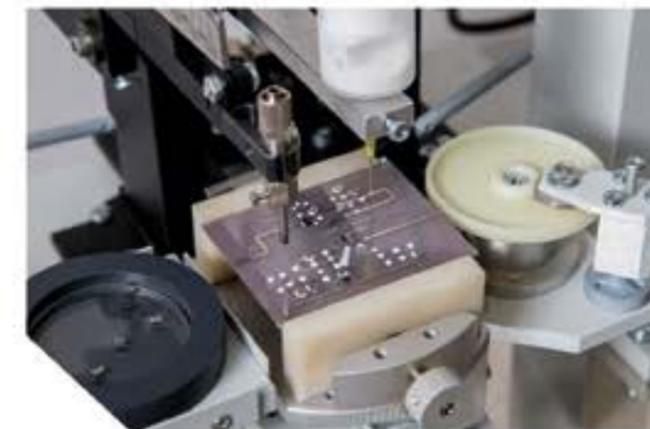
Расчетная производительность установки 1,5-2 тысяч приборов в смену.



### Комплектность:

- Процессорный блок управления для дозирования клея.
- Монтажная головка для захвата полупроводникового кристалла с помощью вакуумасвозможностью перемещения по оси Z от ручки.
- Монтажная головка с дозатором клея (шприца) для нанесения клеевой композиции или с инструментом для штемпелевания при посадке полупроводникового кристалла с возможностью перемещения по оси Z от ручки.
- Микроманипулятор для перемещения монтажной головки с вакуумным захватом по осям X, Y.
- Микроманипулятор для перемещения монтажной головки с дозатором клея по осям X, Y.
- Предметный столик с возможностью регулировки по оси Z (на  $\pm 10$  мм) состоящий из трех технологических позиций:
  - а) для фиксации упаковки типа «гель пак» с полупроводниковыми кристаллами (или плоской поверхности с зеркальной подложкой, на который укладываются кристаллы россыпью).
  - б) для фиксации технологического носителя (платы) размером 48x60, на которой производится монтаж кристаллов на клей.
  - в) для фиксации ванночки с механизмом растирки клея или пасты.

### Образцы собранных приборов



### Технические характеристики:

Размер присоединяемых кристаллов, мм	от 0,3x 0,3 до 10x10
Минимальная высота кристалла, мм	0,1
Ход манипулятора (прецизионное перемещение) по осям X,Y для технологической головки с вакуумным захватом, мм.	10x10
Ход манипулятора (прецизионное перемещение) по осям X,Y для технологической головки с дозатором, мм	10x10
Грубое ручное перемещение предметного стола по координатам X,Y и по углу F, мм/градусы	100x100 /180
Точность монтажа полупроводникового кристалла в корпус или на плату относительно «реперных» знаков, мкм	$\pm 25$
Усилие сжатия	регулируемое
Диапазон регулирования усилия сжатия, Н	1 – 2.5
Микропроцессорное управление	в наличии
Возможность циклической настройки (доза-пауза)	в наличии
Сжатый воздух (на входе), Бар	1-7
Настройка времени дозирования, секунды	0,01 – 30
Регулируемое давление в шприце, Бар	0,1 – 7
Вакуум, кПа	от 25 до 30